

Информационное сообщение

27 февраля 2014 г. в ВЦ РАН имени А.А.Дородницына состоится 4 заседание
междисциплинарного научно-практического семинара по проблеме

«Математическое моделирование в материаловедении электронных наноструктур»

под научным руководством академика Ю.Г.Евтушенко и академика Ю.А.Рыжова

Программа 4 заседания:

Доклады:

**1. Радиационные эффекты в полупроводниках и приборных структурах как
предмет математического моделирования.**

доктор физ.-мат. наук Мордкович Виктор Наумович, ИПТМ РАН
11.00-11.30, обсуждение 10 мин

**2. Радиационные эффекты в СВЧ гетероструктурных приборах и элементах
нанозлектроники**

профессор, д.т.н. Громов Дмитрий Викторович, НИЯУ МИФИ
11.40-12.10, обсуждение 10 мин

Перерыв 12.20-13.00

**3. Многомасштабное моделирование структуры и свойств многослойных
полупроводниковых наноструктур на основе кремния**

зав.сектором, к.ф.-м.н. Абгарян Карина Карленовна, ВЦ РАН
13.00- 13.30, обсуждение 10 мин

**4. Моделирование СВЧ и силовых транзисторов, интегральных схем и модулей
на их основе**

к.т.н. Крымко Михаил Миронович, к.т.н. Савченко Евгений Матвеевич, к.э.н.
Груздов Вадим Владимирович
ОАО «НПП «Пульсар»»
13.40- 14.10, обсуждение 10 мин

Дискуссия по обсуждаемой проблеме 14.20-14.40

Заседание состоится по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, дом 40, 3 этаж конференц-зал

Начало регистрации: 10.30, начало заседания 11.00

Контакты: зав. сектором Абгарян Карина Карленовна,

м.н.с. Сеченых Полина Алексеевна

Телефон: 8 495 938 28 67 (ул. Вавилова дом 42, ком. 158)

8(967) 029 84 20 моб.,

Факс: 8 499 135 61 59

Электронная почта оргкомитета: matmodel2013@gmail.com